

# Языки описания схем

mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Языки описания схем

## Блок 3

Как устроена цифровая аппаратура

Немного физики:  
как схемы из функциональных элементов  
связаны с реальным миром

Лектор:

**Подымов Владислав Васильевич**

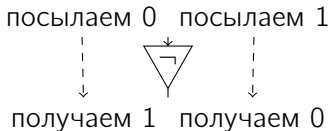
E-mail:

**valdus@yandex.ru**

ВМК МГУ, 2024/2025, осенний семестр

# Вступление

ФЭ отрицания:

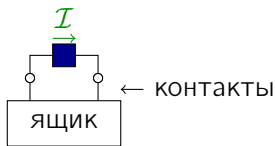


Элемент отрицания — это математическая абстракция реального объекта, в который можно посылать булево значение и получать отрицание этого значения

- ▶ Как выглядит этот объект?
- ▶ Как послать булево значение?
- ▶ Как получить и использовать отрицание значения?

# Как устроена цифровая аппаратура

Как правило, цифровая аппаратура — это «чёрный ящик», содержащий контакты, к которым можно подсоединить провода

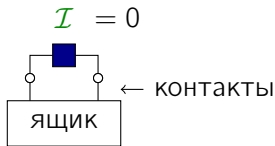


Пару контактов (о о) можно соединить проводником

Если по проводнику потёк желаемый электрический ток, значит, на паре (о о) выставлено значение 1

# Как устроена цифровая аппаратура

Как правило, цифровая аппаратура — это «чёрный ящик», содержащий контакты, к которым можно подсоединить провода



Пару контактов (◦ ◦) можно соединить **проводником**

Если же **тока** в **проводнике** нет, значит, на паре (◦ ◦) выставлено **значение 0**

# Немного физики: закон Ома

## Закон Ома:

$$U = IR$$

- ▶  $I$  — **сила тока** в проводнике, то есть то, насколько много электронов протекает через проводник в единицу времени
  - ▶ единица измерения: **ампер**,  $A$
- ▶  $R$  — **сопротивление** проводника, то есть то, сколько усилий нужно приложить, чтобы переместить каждый электрон через проводник в единицу времени
  - ▶ единица измерения: **Ом**,  $\Omega$
- ▶  $U$  — **напряжение** между концами проводника, то есть те самые усилия, которые прикладываются для перемещения электронов через проводник
  - ▶ единица измерения: **вольт**,  $V$ ,  $V$

# Немного физики: закон Ома

Наиболее «управляемый» параметр в законе Ома — это напряжение:

- ▶ 220В — напряжение в розетках электрической сети квартиры
- ▶ 5В — напряжение в проводах питания USB
- ▶ 12/19/...В — напряжение питания ноутбука
- ▶ 3.3/5/12/...В — напряжения компонентов материнской платы компьютера
- ▶ ...
- ▶ логический ноль и логическая единица, выставленные на паре контактов, — это **заданные уровни напряжения**

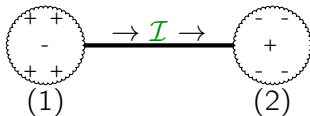
А что такое напряжение?

# Немного физики: напряжение

Напряжение — это работа по перемещению единичного заряда из начальной точки в конечную

Если отбросить многие нюансы: напряжение между двумя точками — это разность **потенциалов** между этими точками

Потенциал — это особое число, которое можно коротко описать так:



(1): много положительных зарядов  $\Rightarrow$  высокий потенциал

(2): много отрицательных зарядов  $\Rightarrow$  низкий потенциал

Отрицательные заряды притягиваются к положительным, и если соединить (1) и (2) проводником, то по нему потечёт **ток**

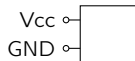
Чем больше разность зарядов между (1) и (2),  
тем выше напряжение между ними,  
и тем больший ток будет течь по проводнику

## Vcc и GND, единица и ноль

У электронного прибора обычно есть **вилка**: два контакта, втыкающиеся в розетку (*обычно больше двух, но не будем углубляться в подробности*)

На контакты розетки извне подаётся требуемое напряжение (*например, переменные 220В в домашней розетке*)

У цифровой аппаратуры обычно тоже есть такая «вилка» — два контакта с постоянным потенциалом (напряжением<sup>1</sup>), подаваемым извне:



- ▶  $V_{cc}^2$  (или  $V_{dd}^2$ ): контакт с высоким напряжением и соответствующее напряжение
- ▶  $GND^3$  (или  $V_{ss}^2$ ): контакт с низким напряжением и соответствующее напряжение

---

1 Схемотехники не любят слово «потенциал»

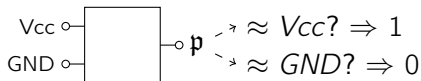
Потенциал точки — это напряжение между ней и нолевым потенциалом

2 «cc» = «common collector», «d» = «drain», «s» = «sink», но можно об этом не думать

3 **GROUND**: потенциал земли, часто считается нолевым



## Vcc и GND, единица и ноль



Каждая точка **p** аппаратуры также обладает некоторым потенциалом

Если потенциал точки **p** (*приблизительно*) равен

- ▶ GND, то в этой точке схемы выставлено значение 0
- ▶ Vcc, то в этой точке схемы выставлено значение 1

В современной цифровой схемотехнике основное внимание уделяется **микросхемам**: аппаратуре, содержащей очень много деталей (*транзисторов — о них речь пойдёт дальше*) в очень маленьком ящике —

до сотен миллионов деталей на квадратный миллиметр в один слой

И как же запихнуть СФЭ в реальный и очень маленький ящик?

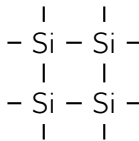
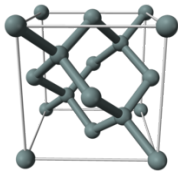
# Немного физики: полупроводники

Современные микросхемы, как правило, основаны на полупроводниках

**Полупроводник** — это материал, в зависимости от внешних условий и уровня подаваемого напряжения способный вести себя и как проводник, и как диэлектрик

Полупроводники, используемые в цифровых схемах, получают добавлением примесей в кристаллы кремния (Si):

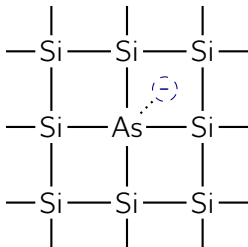
*решётка кристалла Si    схематичное двумерное изображение*



Кристаллический кремний сам по себе не очень удобный полупроводник: он имеет 4 валентных электрона, и все они крепко заняты связями кристаллической решётки

## Немного физики: полупроводники

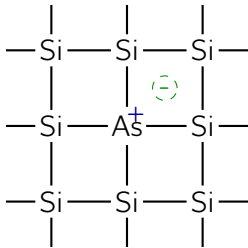
В качестве примеси можно вкrapить в решётку кремния мышьяк (As):



Мышьяк имеет 5 валентных электронов, из них 4 связаны кристаллической решёткой

## Немного физики: полупроводники

В качестве примеси можно вкратить в решётку кремния мышьяк (As):



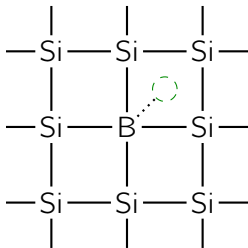
Мышьяк имеет 5 валентных электронов, из них 4 связаны кристаллической решёткой

Оставшийся электрон при небольших усилиях отрывается от атома и передвигается по кристаллической решётке, и так возникает проводимость

Это полупроводник **n-типа** (negative charge)

## Немного физики: полупроводники

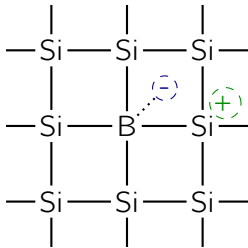
В качестве примеси можно вкратить в решётку кремния бор (B):



Бор имеет 3 валентных электрона, и для связей кристаллической решётки используются они и ещё один электрон бора

## Немного физики: полупроводники

В качестве примеси можно вкrapить в решётку кремния бор (B):



Бор имеет 3 валентных электрона, и для связей кристаллической решётки используются они и ещё один электрон бора

На образовавшееся вакантное место при небольших усилиях переходит электрон с соседнего атома, и в этом атоме образуется **дырка** — так возникает дырочная проводимость

Это полупроводник **p-типа** (positive charge)

## Немного физики: диод

Если в цепи расположить рядом полупроводники  $n$ - и  $p$ -типов, то можно получить нетривиальную проводимость:



Это **полупроводниковый диод**, пропускающий ток в одну сторону и не пропускающий обратный ток:



## Немного физики: диод

Если в цепи расположить рядом полупроводники n- и p-типов, то можно получить нетривиальную проводимость:



Это **полупроводниковый диод**, пропускающий ток в одну сторону и не пропускающий обратный ток:





# Немного физики: диод

Если в цепи расположить рядом полупроводники n- и p-типов, то можно получить нетривиальную проводимость:

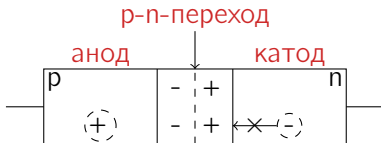


Это **полупроводниковый диод**, пропускающий ток в одну сторону и не пропускающий обратный ток:



# Немного физики: диод

Если в цепи расположить рядом полупроводники n- и p-типов, то можно получить нетривиальную проводимость:

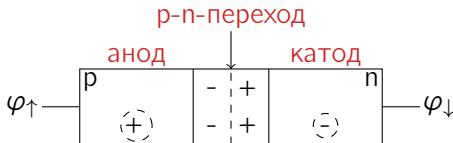


Это **полупроводниковый диод**, пропускающий ток в одну сторону и не пропускающий обратный ток:



## Немного физики: диод

Если в цепи расположить рядом полупроводники n- и p-типов, то можно получить нетривиальную проводимость:



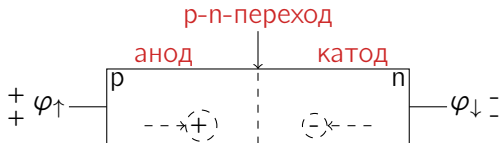
Здесь и дальше:  $\varphi_{\uparrow}$  — высокий потенциал,  
 $\varphi_{\downarrow}$  — низкий потенциал

Это **полупроводниковый диод**, пропускающий ток в одну сторону и не пропускающий обратный ток:



## Немного физики: диод

Если в цепи расположить рядом полупроводники n- и p-типов, то можно получить нетривиальную проводимость:



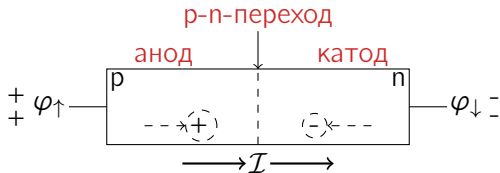
Здесь и дальше:  $\varphi_{\uparrow}$  — высокий потенциал,  
 $\varphi_{\downarrow}$  — низкий потенциал

Это **полупроводниковый диод**, пропускающий ток в одну сторону и не пропускающий обратный ток:



## Немного физики: диод

Если в цепи расположить рядом полупроводники n- и p-типов, то можно получить нетривиальную проводимость:



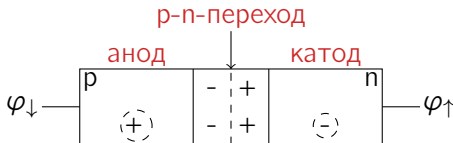
Здесь и дальше:  $\varphi_{\uparrow}$  — высокий потенциал,  
 $\varphi_{\downarrow}$  — низкий потенциал

Это **полупроводниковый диод**, пропускающий ток в одну сторону и не пропускающий обратный ток:



## Немного физики: диод

Если в цепи расположить рядом полупроводники n- и p-типов, то можно получить нетривиальную проводимость:



Здесь и дальше:  $\varphi_{\uparrow}$  — высокий потенциал,  
 $\varphi_{\downarrow}$  — низкий потенциал

Это **полупроводниковый диод**, пропускающий ток в одну сторону и не пропускающий обратный ток:



## Немного физики: диод

Если в цепи расположить рядом полупроводники n- и p-типов, то можно получить нетривиальную проводимость:



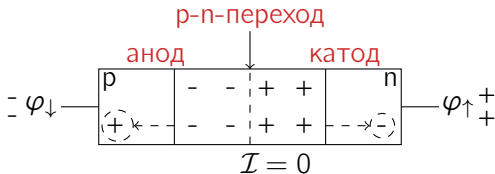
Здесь и дальше:  $\varphi_{\uparrow}$  — высокий потенциал,  
 $\varphi_{\downarrow}$  — низкий потенциал

Это **полупроводниковый диод**, пропускающий ток в одну сторону и не пропускающий обратный ток:



## Немного физики: диод

Если в цепи расположить рядом полупроводники n- и p-типов, то можно получить нетривиальную проводимость:



Здесь и дальше:  $\varphi_{\uparrow}$  — высокий потенциал,  
 $\varphi_{\downarrow}$  — низкий потенциал

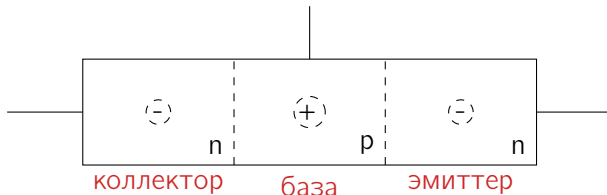
Это **полупроводниковый диод**, пропускающий ток в одну сторону и не пропускающий обратный ток:





# Немного физики: биполярный транзистор

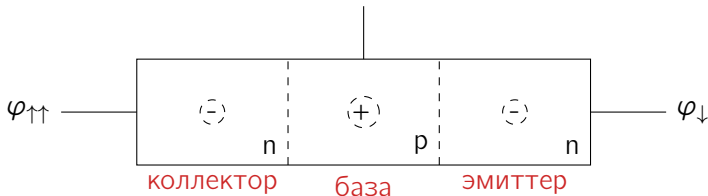
Ещё более нетривиальная проводимость получается, если расположить последовательно полупроводники n-, p- и снова n-типов:



Это биполярный pnp-транзистор: 

# Немного физики: биполярный транзистор

Ещё более нетривиальная проводимость получается, если расположить последовательно полупроводники n-, p- и снова n-типов:



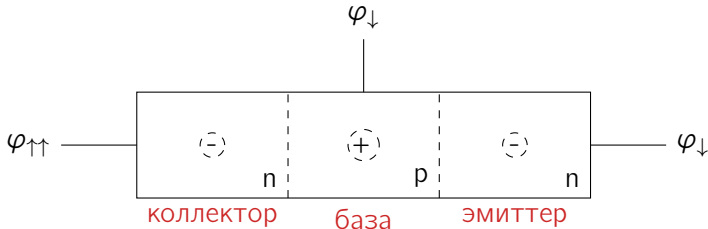
$\varphi_{\uparrow\uparrow}$  — очень высокий потенциал

Это биполярный pnp-транзистор:



# Немного физики: биполярный транзистор

Ещё более нетривиальная проводимость получается, если расположить последовательно полупроводники n-, p- и снова n-типов:

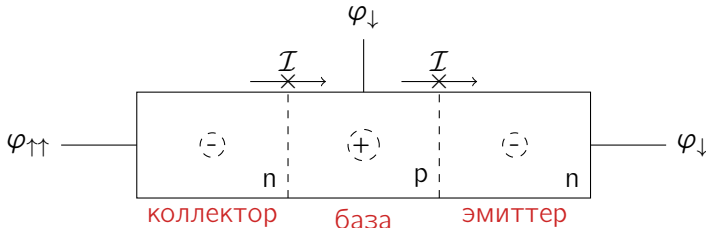


$\varphi_{\uparrow\uparrow}$  — очень высокий потенциал

Это биполярный pnp-транзистор: 

# Немного физики: биполярный транзистор

Ещё более нетривиальная проводимость получается, если расположить последовательно полупроводники n-, p- и снова n-типов:

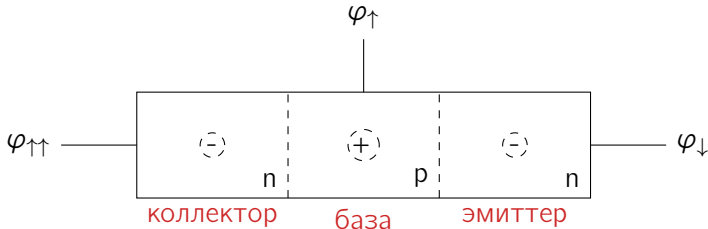


$\varphi_{\uparrow\uparrow}$  — очень высокий потенциал

Это биполярный pnp-транзистор: 

# Немного физики: биполярный транзистор

Ещё более нетривиальная проводимость получается, если расположить последовательно полупроводники n-, p- и снова n-типов:

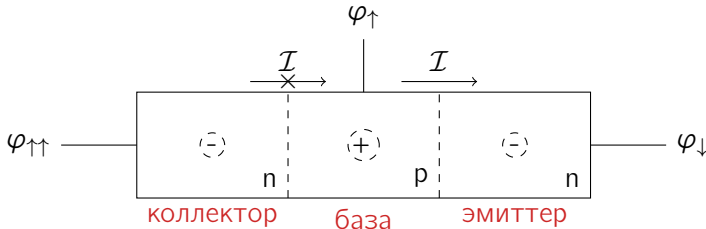


$\varphi_{\uparrow\uparrow}$  — очень высокий потенциал

Это биполярный pnp-транзистор: 

# Немного физики: биполярный транзистор

Ещё более нетривиальная проводимость получается, если расположить последовательно полупроводники n-, p- и снова n-типов:



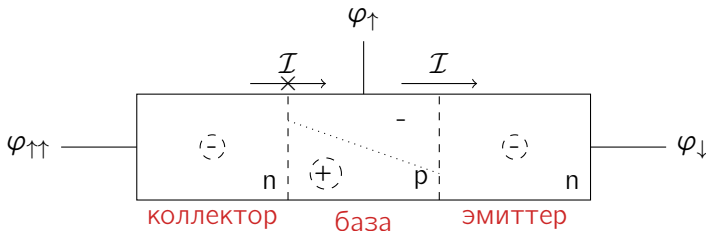
$\varphi_{\uparrow\uparrow}$  — очень высокий потенциал

Это биполярный pnp-транзистор:



# Немного физики: биполярный транзистор

Ещё более нетривиальная проводимость получается, если расположить последовательно полупроводники n-, p- и снова n-типов:



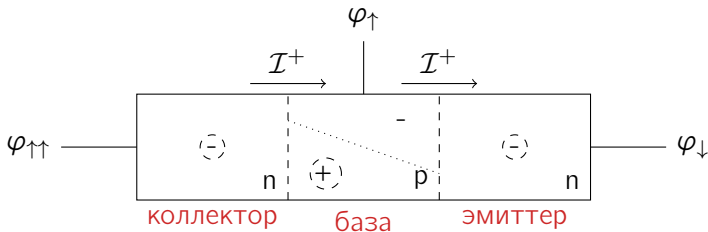
$\varphi_{\uparrow\uparrow}$  — очень высокий потенциал

Это биполярный pnp-транзистор:



# Немного физики: биполярный транзистор

Ещё более нетривиальная проводимость получается, если расположить последовательно полупроводники n-, p- и снова n-типов:



$\varphi_{\uparrow\uparrow}$  — очень высокий потенциал

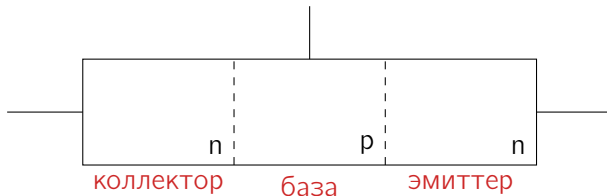
$\mathcal{I}^{+}$  — очень сильный ток

Это биполярный pnp-транзистор:



# Немного физики: биполярный транзистор

Ещё более нетривиальная проводимость получается, если расположить последовательно полупроводники n-, p- и снова n-типов:



$\varphi_{\uparrow\uparrow}$  — очень высокий потенциал

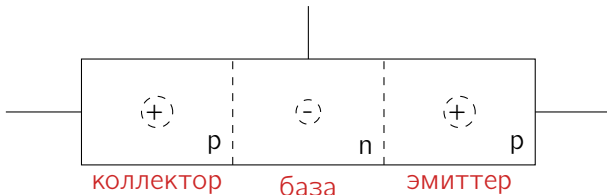
$I^+$  — очень сильный ток

Грубый итог: эмиттер и коллектор соединены проводящим каналом  $\Leftrightarrow$  к базе подведён достаточно высокий потенциал

Это **биполярный pnp-транзистор**: 

# Немного физики: биполярный транзистор

Аналогичные свойства проводимости можно получить, последовательно соединив полупроводники р-, n- и снова р-типов:

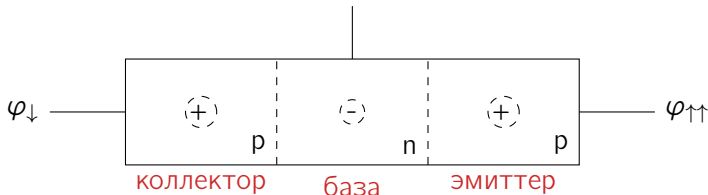


Это биполярный rpn-транзистор:



# Немного физики: биполярный транзистор

Аналогичные свойства проводимости можно получить, последовательно соединив полупроводники р-, n- и снова р-типов:

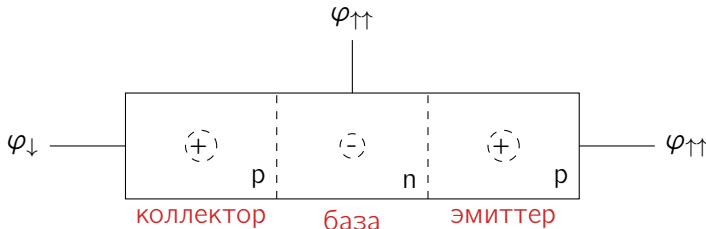


Это биполярный rpn-транзистор:



# Немного физики: биполярный транзистор

Аналогичные свойства проводимости можно получить, последовательно соединив полупроводники р-, n- и снова р-типов:

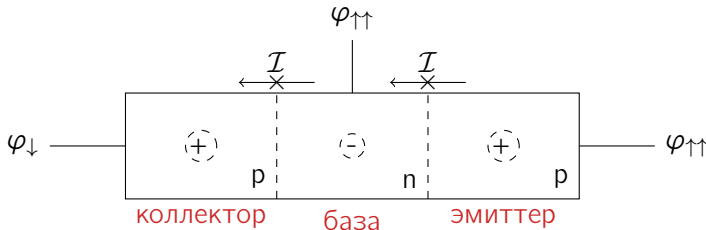


Это биполярный pnp-транзистор:



# Немного физики: биполярный транзистор

Аналогичные свойства проводимости можно получить, последовательно соединив полупроводники р-, n- и снова р-типов:

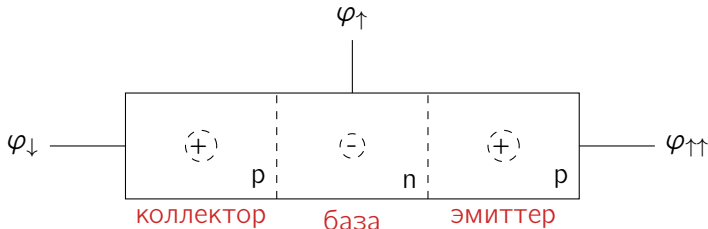


Это биполярный rpn-транзистор:



# Немного физики: биполярный транзистор

Аналогичные свойства проводимости можно получить, последовательно соединив полупроводники р-, n- и снова р-типов:

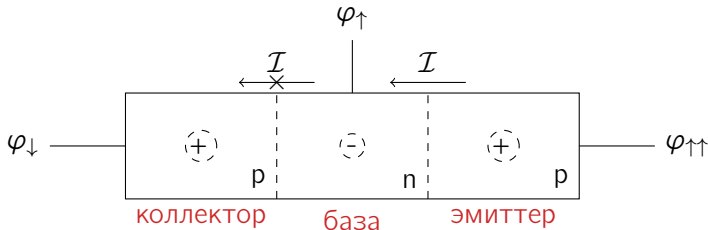


Это биполярный rpn-транзистор:



# Немного физики: биполярный транзистор

Аналогичные свойства проводимости можно получить, последовательно соединив полупроводники р-, n- и снова р-типов:

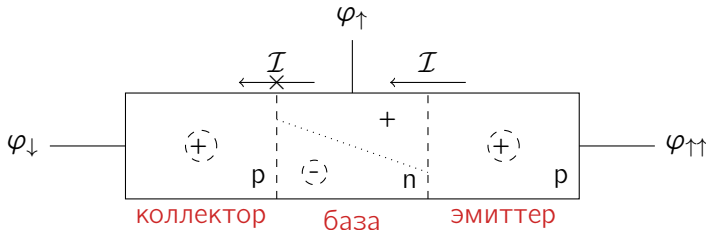


Это биполярный pnp-транзистор:



# Немного физики: биполярный транзистор

Аналогичные свойства проводимости можно получить, последовательно соединив полупроводники р-, n- и снова р-типов:



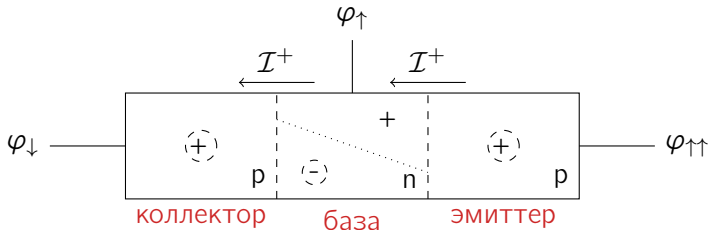
Это биполярный pnp-транзистор:





# Немного физики: биполярный транзистор

Аналогичные свойства проводимости можно получить, последовательно соединив полупроводники р-, n- и снова р-типов:

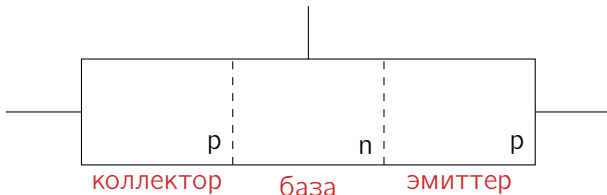


Это биполярный pnp-транзистор:



# Немного физики: биполярный транзистор

Аналогичные свойства проводимости можно получить, последовательно соединив полупроводники р-, n- и снова р-типов:



Грубый итог: коллектор и эмиттер соединены проводящим каналом  $\Leftrightarrow$  к базе подведён достаточно низкий потенциал

Это **биполярный pnp-транзистор**: 

# Немного физики: МОП-транзистор

**МОП**-транзисторы (с индуцированным каналом) — это полевые транзисторы, из которых обычно строятся цифровые микросхемы

МОП-транзистор имеет несколько слоёв:

1. проводящий **затвор**

- ▶ **М**еталл, хотя сейчас вместо металлического напыления используются более хитрые технологии

2. диэлектрик, отделяющий затвор от подложки

- ▶ (ди)**О**ксид кремния, то есть стекло, хотя могут использоваться и другие изоляторы

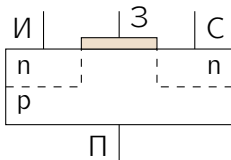
3. **П**олупроводники, образующие

**исток** (эмиттер), **сток** (коллектор) и **подложку** (базу)

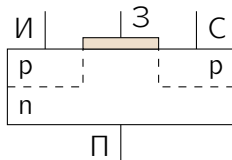
В отличие от биполярного транзистора, в котором канал проводимости открывается протекающим **током**, в полевом транзисторе канал открывается электрическим **полем**, создаваемым напряжением между затвором и подложкой

# Немного физики: МОП-транзистор

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор

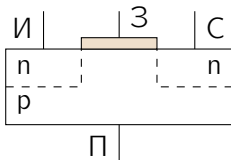


Если не принимать во внимание затвор, то МОП-транзисторы очень похожи на биполярные транзисторы, но всё же они применяются совсем по-другому:

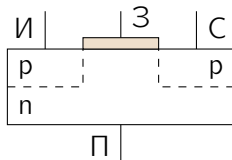
- ▶ на контакты МОП-транзистора не подводится «очень большой потенциал»: МОП-транзистор в цифровой схеме обычно оперирует только потенциалами  $\varphi_{\downarrow} = GND$  и  $\varphi_{\uparrow} = V_{cc}$

# Немного физики: МОП-транзистор

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор

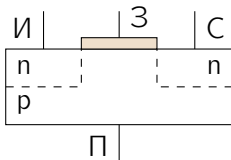


Если не принимать во внимание затвор, то МОП-транзисторы очень похожи на биполярные транзисторы, но всё же они применяются совсем по-другому:

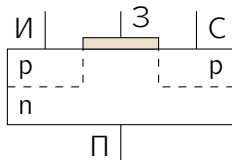
- ▶ основное назначение МОП-транзистора — передача потенциалов с контактов  $V_{cc}$  и  $GND$  во внутренние части схемы и на внешние контакты, с которых уровни напряжения будут считываться другими электрическими схемами

# Немного физики: МОП-транзистор

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор



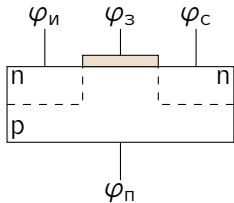
Если не принимать во внимание затвор, то МОП-транзисторы очень похожи на биполярные транзисторы, но всё же они применяются совсем по-другому:

- ▶ слишком сильный ток через МОП-транзистор, как правило, означает короткое замыкание в схеме, и потому нежелателен

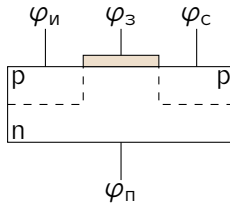
# Немного физики: МОП-транзистор

## МОП-транзистор в цифровых схемах

n-МОП-транзистор



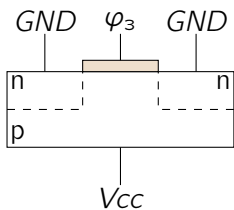
p-МОП-транзистор



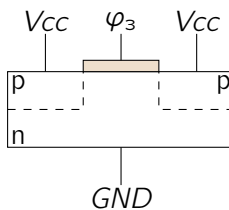
# Немного физики: МОП-транзистор

## МОП-транзистор в цифровых схемах

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор



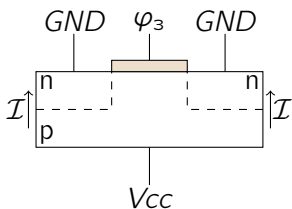
Если  $\varphi_n = V_{cc}/GND$  и на сток или исток подан потенциал  $GND/V_{cc}$ , то между стоком/истоком и подложкой возникает немалый ток



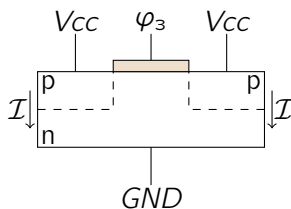
# Немного физики: МОП-транзистор

## МОП-транзистор в цифровых схемах

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор

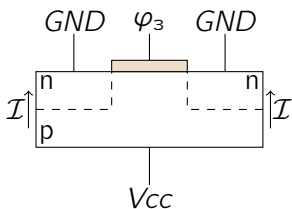


Если  $\varphi_n = V_{cc}/GND$  и на сток или исток подан потенциал  $GND/V_{cc}$ , то между стоком/истоком и подложкой возникает немалый ток

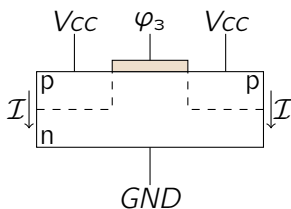
# Немного физики: МОП-транзистор

## МОП-транзистор в цифровых схемах

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор



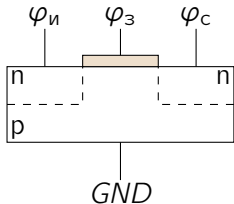
Если  $\varphi_n = V_{cc}/GND$  и на сток или исток подан потенциал  $GND/V_{cc}$ , то между стоком/истоком и подложкой возникает немалый ток

Такое поведение нежелательно, так как назначение МОП-транзистора — передача потенциала, а не поддержание тока

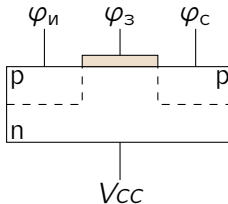
# Немного физики: МОП-транзистор

## МОП-транзистор в цифровых схемах

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор



Если  $\varphi_n = V_{cc}/GND$  и на сток или исток подан потенциал  $GND/V_{cc}$ , то между стоком/истоком и подложкой возникает немалый ток

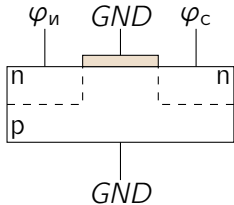
Такое поведение нежелательно, так как назначение МОП-транзистора — передача потенциала, а не поддержание тока

Поэтому  $\varphi_n = GND/V_{cc}$

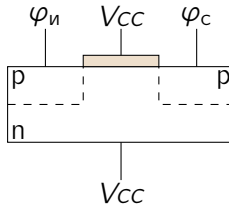
# Немного физики: МОП-транзистор

## МОП-транзистор в цифровых схемах

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор

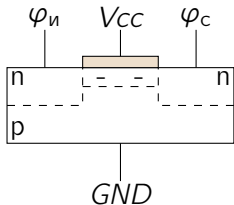


Если  $\varphi_3 = GND/V_{CC}$ , то исток и сток изолированы

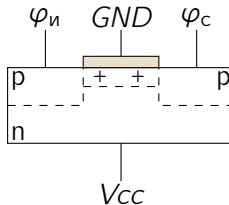
# Немного физики: МОП-транзистор

## МОП-транзистор в цифровых схемах

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор



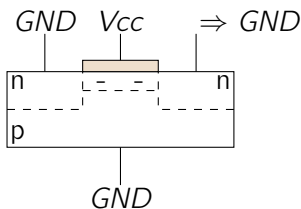
Если  $\varphi_{\text{з}} = GND/V_{\text{cc}}$ , то исток и сток изолированы

Если  $\varphi_{\text{з}} = V_{\text{cc}}/GND$ , то основные носители заряда подложки отталкиваются от затвора, а неосновные — притягиваются, и область между стоком и истоком, насыщенная неосновными носителями заряда, ведёт себя как полупроводник того же типа, что и исток-сток: образует **канал проводимости**

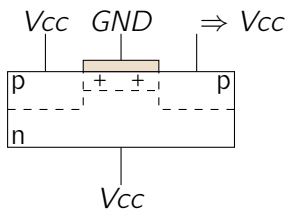
# Немного физики: МОП-транзистор

## МОП-транзистор в цифровых схемах

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор

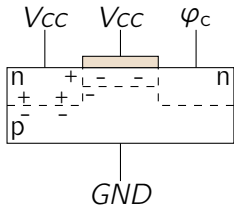


Если  $\varphi_{и} = GND/V_{cc}$ , а в стоке созданы условия *полной изоляции*, при которых потенциал может легко изменяться небольшим кратковременным током, то потенциалы стока и истока при открытом канале *примерно* выравниваются

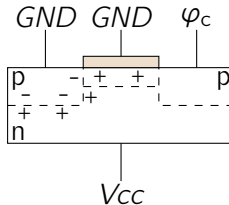
# Немного физики: МОП-транзистор

## МОП-транзистор в цифровых схемах

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор

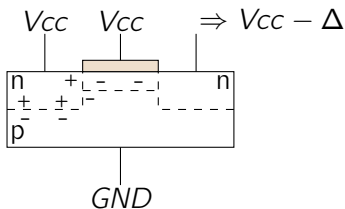


Если  $\varphi_{in} = V_{cc}/GND$ , то между истоком и подложкой образуется широкий p-n-переход

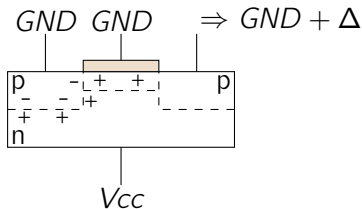
# Немного физики: МОП-транзистор

## МОП-транзистор в цифровых схемах

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор



Если  $\varphi_{in} = V_{cc}/GND$ , то между истоком и подложкой образуется широкий p-n-переход

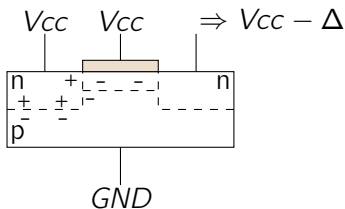
На преодоление перехода носителями заряда тратится заметно немалая энергия, то есть на нём заметно падает напряжение, и потенциалы  $\varphi_{in}$ ,  $\varphi_c$  будут заметно различаться после «выравнивания»



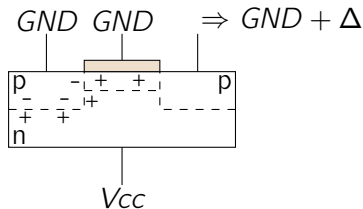
# Немного физики: МОП-транзистор

## МОП-транзистор в цифровых схемах

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор

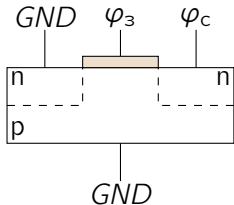


Такое поведение нежелательно, так как назначение МОП-транзистора в цифровой схеме — как можно более точная передача потенциалов  $V_{cc}$  и  $GND$

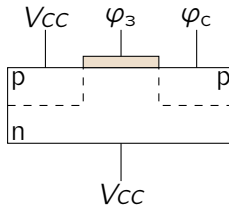
# Немного физики: МОП-транзистор

## МОП-транзистор в цифровых схемах

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор



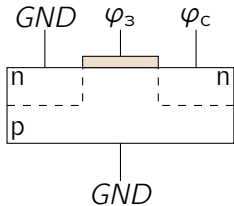
Такое поведение нежелательно, так как назначение МОП-транзистора в цифровой схеме — как можно более точная передача потенциалов  $V_{cc}$  и  $GND$

Поэтому  $\varphi_{и} = GND / V_{cc}$

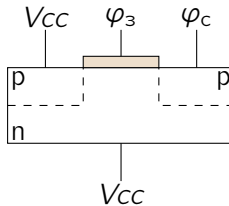
# Немного физики: МОП-транзистор

## МОП-транзистор в цифровых схемах

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор

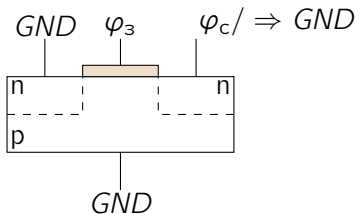


*Итог.* При «правильном» использовании МОП-транзистора  $\varphi_{и} = \varphi_{п} = GND/V_{CC}$ , и возможны ровно два состояния: канал закрыт и сток изолирован от истока, либо канал открыт и сток связан с истоком почти идеальным проводником

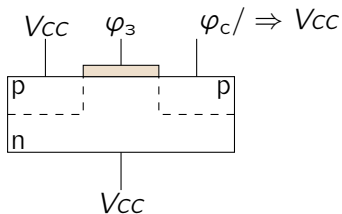
# Немного физики: МОП-транзистор

## МОП-транзистор в цифровых схемах

n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор

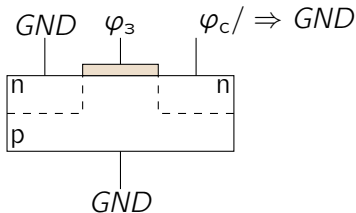


*Итог.* При «правильном» использовании МОП-транзистора  $\varphi_n = \varphi_p = GND/V_{CC}$ , и возможны ровно два состояния: канал закрыт и сток изолирован от истока, либо канал открыт и сток связан с истоком почти идеальным проводником

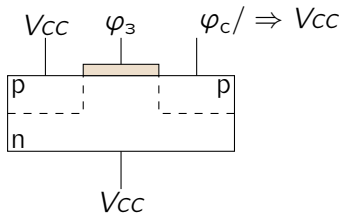
# Немного физики: МОП-транзистор

## МОП-транзистор в цифровых схемах

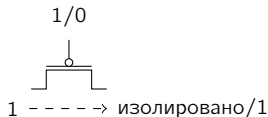
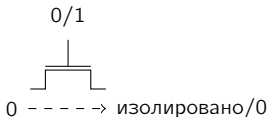
n-МОП-транзистор



p-МОП-транзистор



Так как потенциалы стока и подложки при «правильном» использовании равны, их обычно замыкают проводником, и контакт подложки в схематичном изображении опускается:



# КМОП

Для полноценной передачи обоих значений 0 и 1 в цифровых схемах используется технология **КМОП**:<sup>1</sup>

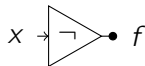
- ▶ Создаётся общая подложка р-типа
- ▶ В эту подложку вкрапляются области n-типа: стоки и истоки n-МОП-транзисторов
- ▶ В основную подложку вставляются **колодцы**: области n-типа, подложки р-МОП-транзисторов
- ▶ В колодцы вкрапляются области р-типа: стоки и истоки р-МОП-транзисторов
- ▶ Контакты транзисторов и внешние контакты схемы соединяются проводниками
  - ▶ согласно логике схемы, и при этом
  - ▶ так, чтобы через каналы n-транзисторов передавалась только единица, а через каналы р-транзисторов — только ноль

---

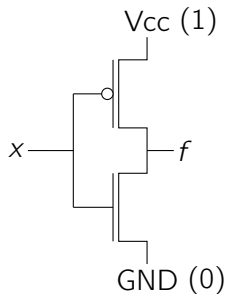
<sup>1</sup> Комплементарные **МОП**-транзисторы

# КМОП и СФЭ

СФЭ:

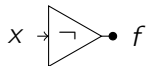


То же самое в КМОП:

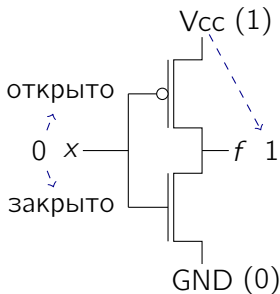


# КМОП и СФЭ

СФЭ:



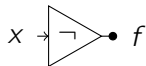
То же самое в КМОП:



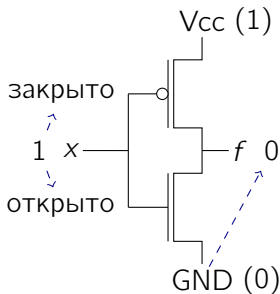


# КМОП и СФЭ

СФЭ:

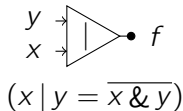


То же самое в КМОП:

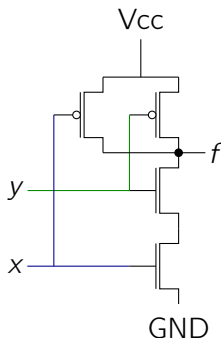


# КМОП и СФЭ

СФЭ:



То же самое в КМОП:

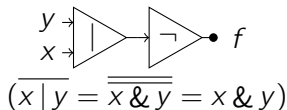


— разветвление провода

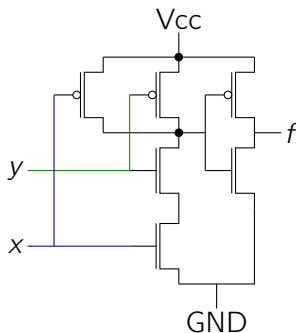
— непересекающиеся вертикальный и горизонтальный провод

# КМОП и СФЭ

СФЭ:



То же самое в КМОП:



Любую СФЭ можно легко реализовать как КМОП-схему: достаточно реализовать каждый ФЭ и соединить проводниками выбранные точки схемы так, как они соединены в СФЭ